

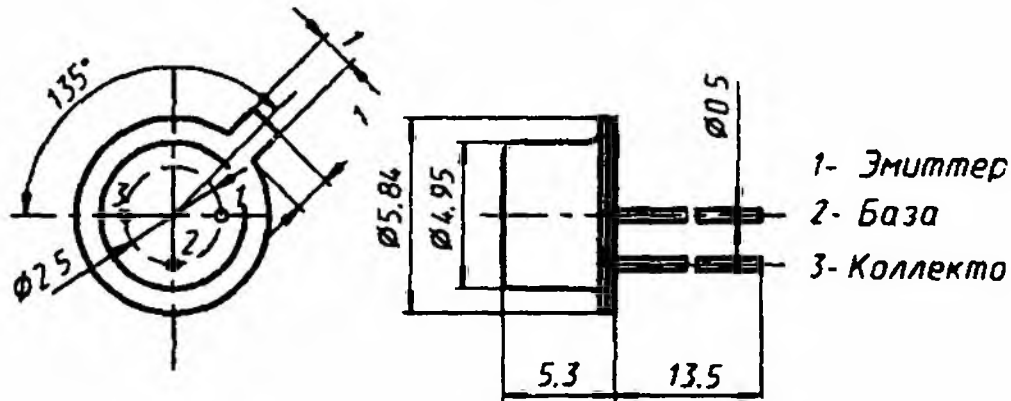
**2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г,
КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г,
КТ117АМ, КТ117БМ, КТ117ВМ, КТ117ГМ**

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные одно-переходные с базой *n*-типа. Предназначены для применения в маломощных генераторах. Выпускаются в металлическом корпусе с гибкими выводами (2Т117(А-Г), КТ117(А-Г)) и в пластмассовом корпусе с гибкими выводами (КТ117(АМ-ГМ)). Тип прибора указывается на корпусе и этикетке.

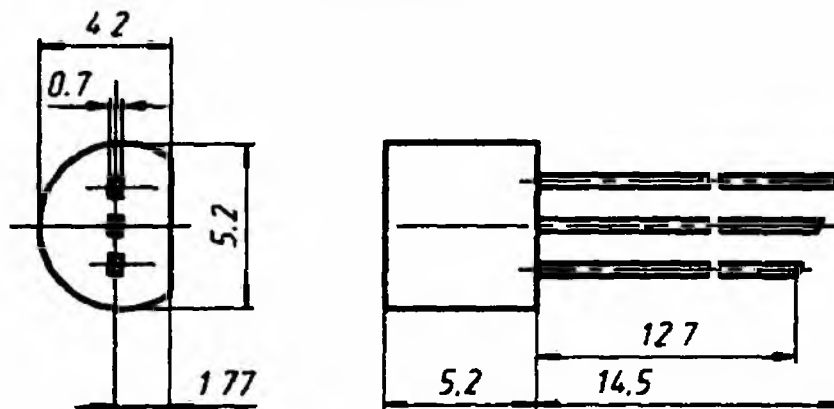
Масса транзистора в металлическом корпусе не более 0,45 г, в пластмассовом не более 0,3 г.

Изготовитель — государственный Московский завод «Старт», г. Москва.

2Т117(А-Г), КТ117(А-Г)



КТ117(АМ-ГМ)



Электрические параметры

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{Б1Б2} = 10$ В:

$T = +25$ °С:

2Т117А, 2Т117В, КТ117А, КТ117В, КТ117АМ, КТ117ВМ	0,5...0,7
2Т117Б, 2Т117Г	0,65...0,8

KT117Б, KT117Г, KT117БМ, KT117ГМ...	0,65...0,9
$T = +70\text{ }^{\circ}\text{C}$:	
2T117А, 2T117В, KT117А, KT117В, KT117АМ, KT117ВМ	0,45...0,7
2T117Б	0,6...0,85
2T117Г	0,6...0,8
KT117Б, KT117Г, KT117БМ, KT117ГМ...	0,6...0,9
$T = -60\text{ }^{\circ}\text{C}$:	
2T117А, 2T117В, KT117А, KT117В, KT117АМ, KT117ВМ	0,5...0,8
2T117Б, 2T117Г	0,65...0,9
KT117Б, KT117Г, KT117БМ, KT117ГМ...	0,65...0,95
Максимальная частота генерации	200 кГц
Время включения при $U_{Б1Б2} = 10\text{ В}$, $I_3 = 50\text{ мА}$, не более:	
$T = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$	3 мкс
$T = -60...+125\text{ }^{\circ}\text{C}$	5 мкс
Остаточное напряжение эмиттер—база, не более:	
при $T = -60...+25\text{ }^{\circ}\text{C}$	5 В
при $I_3 = 10\text{ мА}$, $T = +70\text{ }^{\circ}\text{C}$ для 2T117А, 2T117Б, 2T117В, 2T117Г	4 В
при $I_3 = 50\text{ мА}$, $T = +70\text{ }^{\circ}\text{C}$ для KT117А, KT117Б, KT117В, KT117Г, KT117АМ, KT117БМ, KT117ВМ, KT117ГМ	4 В
Ток включения эмиттера при $U_{Б1Б2} = 10\text{ В}$, не более	20 мкА
Ток выключения эмиттера при $U_{Б1Б2} = 20\text{ В}$, не менее	1 мА
Ток модуляции, не менее	10 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{Б1Б2} = 30\text{ В}$, не более:	
$T = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1 мкА
$T = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$	10 мкА
Межбазовое сопротивление:	
$T = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$:	
2T117А, 2T117Б	4...7,5 кОм
2T117В, 2T117Г	6...9 кОм
KT117А, KT117Б, KT117АМ, KT117БМ KT117В, KT117Г, KT117ВМ, KT117ГМ...	4...9 кОм
KT117В, KT117Г, KT117ВМ, KT117ГМ...	8...12 кОм
$T = +70\text{ }^{\circ}\text{C}$:	
2T117В, 2T117Г	6...15 кОм
KT117В, KT117Г, KT117ВМ, KT117ГМ...	6...18 кОм
$T = -60\text{ }^{\circ}\text{C}$:	
2T117В, 2T117Г	3...8,5 кОм

КТ117В, КТ117Г	4...12 кОм
$T = -45\text{ °C}$:	
КТ117ВМ, КТ117ГМ	4...12 кОм
Температурный коэффициент межбазового сопротивления	0,1...0,9 %/°C

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное межбазовое напряжение	30 В
Постоянное напряжение база—эмиттер	30 В
Постоянный ток эмиттера	50 мА
Импульсный ток эмиттера при $t_{и} = 10\text{ мкс}$, $Q = 200$	1 А
Постоянная рассеиваемая мощность эмиттера:	
при $T = -60...+35\text{ °C}$	300 мВт
при $T = +125\text{ °C}$	15 мВт
Температура р-п перехода	+130 °C
Температура окружающей среды:	
2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г, КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г	-60...+125 °C
КТ117АМ, КТ117БМ, КТ117ВМ, КТ117ГМ ..	-45...+125 °C